

Подложки из арсенида галлия (aAs)



Технические характеристики

Диаметр, мм	100
Толщина, мкм	450; 625
Отклонение от номинала, мкм	± 25
Кристаллографическая ориентация, °	(100); (100)+10°; (111) A
Тип проводимости	N
Ориентационные срезы по стандарту	SEMI EJ
Полировка	Двухсторонняя
Легирующая примесь	Si
Подвижность носителей заряда, см ² /В·сек	> 1200
Концентрация носителей заряда, см ⁻³	От 1·10 ¹⁷ до 3·10 ¹⁸
Плотность дислокаций, см ⁻²	< 500
TTV минимум, мкм	2
TTV стандарт, мкм	до 5